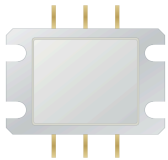
2300–3900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 50 dBm (típico)

LCT-2300-3900-PS50T · 2300–3900 MHz · GaN Transistor de potência com casamento interno.



Valores da tabela RF: PSAT 50 dBm (típico); Ganho de potência 12 dB (típico); PAE 50 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS.

GF136GD

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

As portas RF exigem capacitores externos de bloqueio DC.

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensões do encapsulamento: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

Características RF

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	2300	-	3900	MHz
Potência de saída saturada	-	49	50	-	dBm
Ganho de potência	-	11	12	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	45	50	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	-	1.5	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de estrangulamento [1]	-	-4	-	-2	V
Corrente reversa da porta [2]	-	-	-	0.01	A

[1] VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA

[2] VDS = 0 V; VGS = -10 V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	50	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	175	°C
Temperatura máxima do canal	-	-	-	200	°C

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	24 × 15.9 × 4.4	mm
Vão total dos terminais	17.4	mm

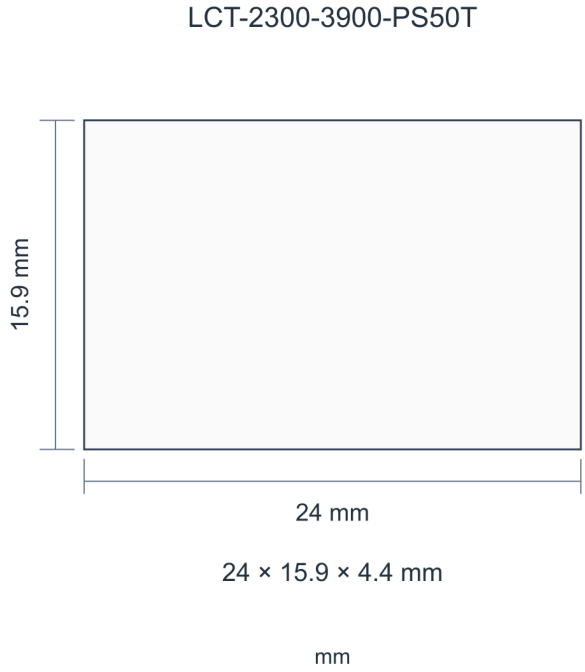
Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Notas de integração

GF136GD Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF As portas RF exigem capacitores externos de bloqueio DC. Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Desenho dimensional mecânico

Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.

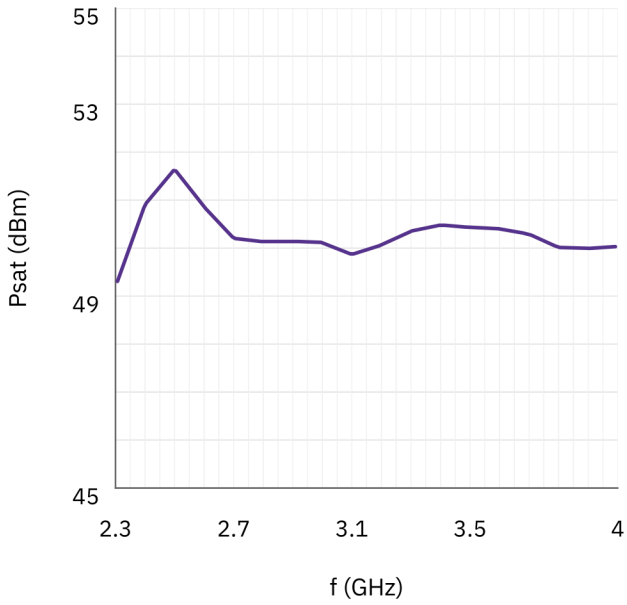


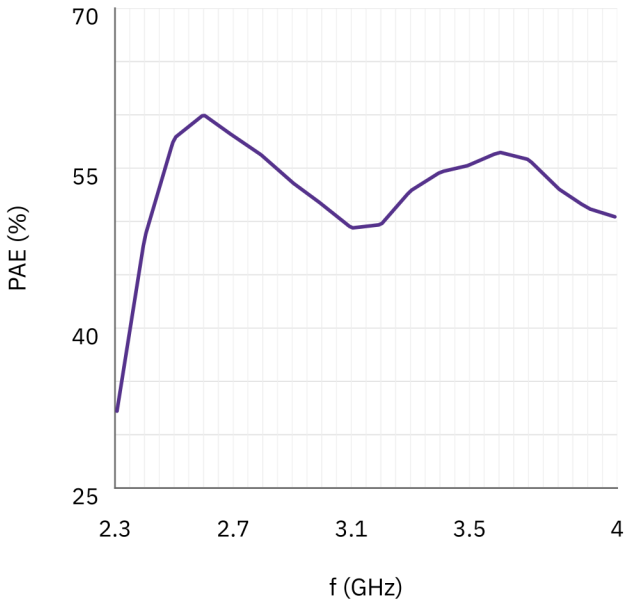
Curvas de desempenho

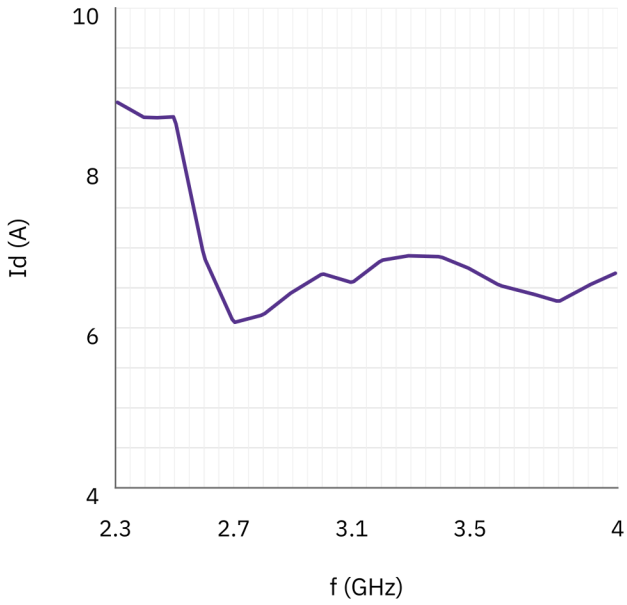
Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

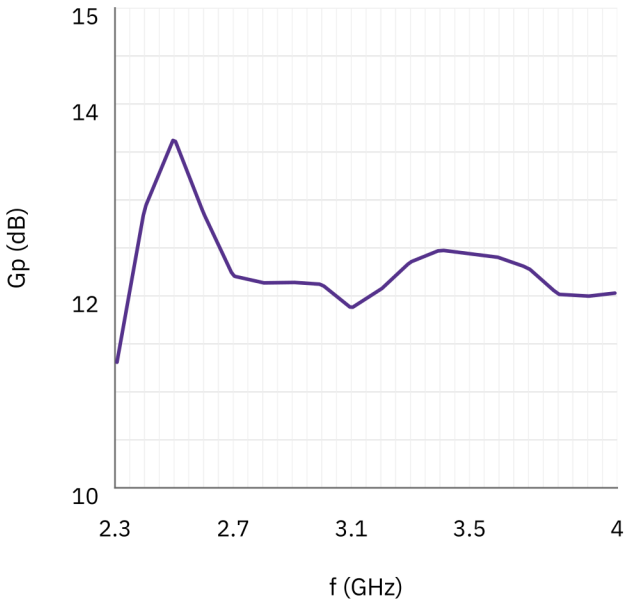
Onda contínua (CW) — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: Vd=+28V; Vg=-3.3V; Pin=38dBm. As leituras são aproximadas.









Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.